

UDC 621.316.923.027.2  
K 31



# 中华人民共和国国家标准

GB 13539.4—92

---

## 低 压 熔 断 器 半导体器件保护用熔断体的补充要求

Low-voltage fuses  
Supplementary requirements for fuse-links for the protection  
of semiconductor devices

1992-07-01 发布

1993-03-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
低 压 熔 断 器  
半导体器件保护用熔断体的补充要求

GB 13539.4—92

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1993年3月第一版 2005年11月电子版制作

\*

书号:155066·1-26327

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求

GB 13539.4—92

### Low-voltage fuses Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices

本标准参照采用国际标准 IEC 269-4(1986)《低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求》。

本标准应与 GB 13539.1—92《低压熔断器 基本要求》一起使用。除非本标准另有说明,半导体器件保护用熔断体,还应符合 GB 13539.1 的规定。

#### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了半导体器件保护用熔断体的额定值、正常使用下的温升、耗散功率、时间-电流特性、分断能力、截断电流特性、 $I^2t$  特性、电弧电压特性、试验和标志。

本标准适用于交流额定电压不超过 1 200V 或直流额定电压不超过 1 500V 的电路中具有半导体器件的设备上使用的熔断体。

注:① 在多数情况下,以组合设备的一部分作为熔断体的底座。由于设备种类繁多,难以作出一般的规定。组合设备是否适合用作熔断体的底座,应由用户与制造厂协商。但是,当采用独立的熔断器底座或支持件时,则它们应符合 GB 13539.1 的有关规定。

② 这种熔断体通常称为“半导体熔断体”。

#### 2 引用标准

GB 321 优先数和优先数系

GB 13539.1 低压熔断器 基本要求

#### 3 术语、符号、代号

##### 3.1 术语

##### 3.1.1 半导体器件 semiconductor device

基本特性是由于载流子在半导体中流动引起的一种器件。

##### 3.1.2 半导体熔断体 semiconductor fuse-link

在规定条件下,能够分断 7.2 范围内的任何电流值的一种限流熔断体。

注:GB 13539.1 中术语:“(熔断体的)使用类别”本标准不适用。

##### 3.2 符号

$\tau$  时间常数

#### 4 分类

GB 13539.1 的规定不适用。

国家技术监督局 1992-07-01 批准

1993-03-01 实施